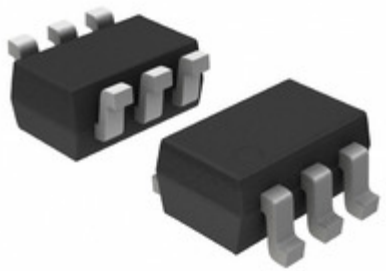










	<h2>NTJS4160NT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTJS4160NT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 1.8A SC88-6</p> <p>Datenblätter:  NTJS4160NT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 83272 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTJS4160NT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 1.8A SC88-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	83272 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Verlustleistung (max)	300mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 2.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.75nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTJS4160NT1G ist neu im Original, Suche NTJS4160NT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTJS4160NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTJS4160NT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTJS4151PT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.3A SOT-363</p>	 <p>NTJS4405NT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 1A SOT-363</p>	 <p>NTJS4151PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.3A SC-88</p>	 <p>NTJS4405NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 1A SOT-363</p>
 <p>NTJS4405UT1 ON NTJS4405UT1 ON</p>	 <p>NTJS3157NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-363</p>	 <p>NTJS3157NT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-363</p>	 <p>NTJS4405NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 1A SOT-363</p>

heiße Teile

Mehr

0402YC102MAT2A	08055A131FAT2A	AD6720ABCZ	D AD7243ANZ	APL5320-33S5I-TRG
BK60C-048L-021F30H	CGA2B3X7R1V683K050BB	D CZA06S04100050HEA	ELM9740CBA-S	IR3500AMTRPBF.
LT1375IS8	MMSZ4696T1G	NTJD1155LT1G	NTJD2152PT1	NTJD2152PT1G
D NTJD3115PT1G	NTJD3158CT1G	NTJD3158CT2G	NTJD4001NT1G	NTJD4001NT2G
NTJD4105CT1G	NTJD4105CT2G	NTJD4152PT1	NTJD4152PT1G	NTJD4158CT1G
NTJD4158CT2G	NTJD4401NT1	D NTJD4401NT1G	NTJD4401NT2	NTJD5121NT1G
NTJD5121NT2G	D NTJS3151PT1G	NTJS3157NT1G	NTJS4151PT1G	NTJS4405NT1G
NTJS4405NT4G	NTJS4405UT1	P82B96DGKR	R1LV0816ASA-5SI	RK73B2HTTE751J
SMAJ33CA	SMCJ85CA-E3/9AT	SMF110CA-TP	D SMJ316KB7103KFHT	SP3220EBCA-L/TR
STM32L151RCY6TR	TFM-107-02-L-D-K-TR	TT375N14KOF	UAF42AUE4	VOS618A-T

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited